

## ПРОТОКОЛ № 23

заседания диссертационного совета Д 212.267.07, созданного на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»

от 28 апреля 2015 г.

Время начала заседания: 14.30

Время окончания заседания: 15.00

Присутствовали 18 из 24 членов диссертационного совета:

1. доктор физико-математических наук Ивонин И.В. – заместитель председателя диссертационного совета
2. доктор физико-математических наук Киреева И.В. – учёный секретарь диссертационного совета
3. доктор физико-математических наук Бордовицын В.А.
4. доктор физико-математических наук Брудный В.Н.
5. доктор физико-математических наук Войцеховский А.В.
6. доктор физико-математических наук Давыдов В.Н.
7. доктор физико-математических наук Дударев Е.Ф.
8. доктор физико-математических наук Караваев Г.Ф.
9. доктор физико-математических наук Коротаев А.Д.
10. доктор физико-математических наук Лавров П.М.
11. доктор физико-математических наук Потехаев А.И.
12. доктор физико-математических наук Толбанов О.П.
13. доктор физико-математических наук Трифонов А.Ю.
14. доктор физико-математических наук Тютюрев В.Г.
15. доктор физико-математических наук Тюменцев А.Н.
16. доктор физико-математических наук Чумляков Ю.И.
17. доктор физико-математических наук Шаповалов А.В.
18. доктор физико-математических наук Шарапов А.А.

### **Повестка дня:**

О приеме к защите диссертации научного сотрудника открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов» Шмаргунова Антона Владимировича «Нелинейная зависимость высоты барьера от смещения и природа аномалий характеристик контактов с барьером Шотки» по специальности 01.04.10 – Физика полупроводников на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук (научный руководитель – доктор технических наук, профессор Божков Владимир Григорьевич).

**Диссертационный совет заслушал председателя комиссии по диссертации А.В. Шмаргунова доктора физико-математических наук О.П. Толбанова, огласившего заключение комиссии:**

- о соответствии темы и содержания диссертации А.В. Шмаргунова специальности 01.04.10 – Физика полупроводников;

- о полноте изложения материалов диссертации в 5 статьях в научных рецензируемых журналах, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени доктора и кандидата наук (все статьи опубликованы в зарубежных журналах, включенных в Web of Science и Scopus), 1 патенте, 1 публикации в сборнике материалов международной конференции;

- о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», показавшей, что итоговая оценка оригинальности текста составляет 97,53 %, а оставшиеся 2,47 % приходятся на 34 источника и представляют собой корректные совпадения отдельных слов, фраз, определений и формул с корректно указанной на них ссылкой, цитируемой литературы;

- о возможности принять диссертацию А.В. Шмаргунова к защите.

**На основании заключения комиссии диссертационный совет принял следующее решение:**

1. Принять к защите диссертацию А.В. Шмаргунова (результаты голосования: за – 18, против – нет, воздержавшихся – нет).

2. Назначить официальными оппонентами:

**Шашкина Владимира Ивановича**, доктора физико-математических наук по специальности 01.04.10 – Физика полупроводников, профессора, заведующего отделом технологии наноструктур и приборов федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт физики микроструктур Российской академии наук (г. Нижний Новгород), широко известного своими работами в области исследования контакта металл-полупроводник и управляемого изменения его высоты барьера,

**Трояна Павла Ефимовича**, доктора технических наук по специальности 01.04.04 – Физическая электроника, профессора, заведующего кафедрой физической электроники федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники», известного специалиста в области исследования тонких плёнок и гетероструктур, давших на это свое согласие в письменном виде.

3. Ведущей организацией назначить федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук, г. Новосибирск, с письменного согласия руководства организации. В Институте физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН (г. Новосибирск) работают квалифицированные специалисты по направлению 01.04.10 – Физика полупроводников, известные своими исследованиями поверхности полупроводника и различных границ раздела.

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, разрешить печатание автореферата на правах рукописи.

5. Защиту назначить на 24 сентября 2015 г. в 14<sup>30</sup> ч. в аудитории 211 главного корпуса СФТИ ТГУ.

